

RE200B 传感器

RE200B 特点：

封装 T0-5
基片材料 硅

RE200B 尺寸参数：

灵敏元面积 2.0mm × 1.0mm × Gap 1.0mm Dual, 双元
基片厚度 0.5mm
窗口尺寸 4 × 3mm

RE200B 基本特性：

工作波长 5-14 μ m
平均透过率 > 75%
输出信号 >2.2V (420 ° k 黑体 1Hz 调制频率 0.3-3.0Hz 带宽 72.5db 增益)
灵敏度 3300V/W
探测率(D*) 1.5×10^8 cmHz^{1/2}/W
噪声(Vp-p) < 200mV (mVp-p) (25)
平衡度 < 20%

RE200B 电气参数：

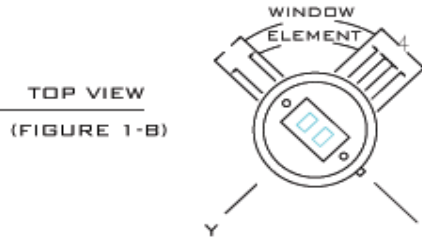
工作电压 3-10V
工作电流 8.5-24 μ A (VD=10V, Rs=47k , 25)
源极电压 0.4-1.1V (VD=10V, Rs=47k , 25)

RE200B 环境条件：

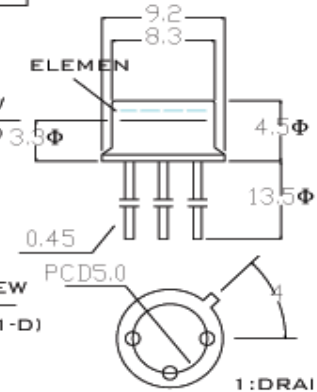
工作温度 -20 - +70
保存温度 -35 - +80
视场 中心角 138 ° × 125 °

RE200B

CONFIGURATION (FIGURE 1)



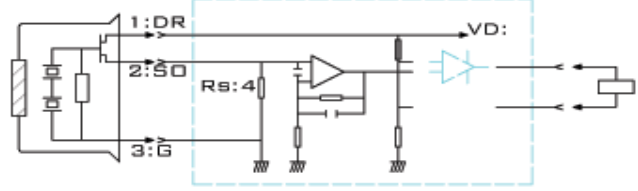
SIDE VIEW
(FIGURE 1-C)



BASE VIEW
(FIGURE 1-D)

- 1: DRAIN
- 2: SOURC
- 3: GROUND

CIRCUIT CONFIGURATION (FIGURE 2)



UNIT : MM

S MEASUREMENT
*MEASUREMENT AMP. : NON-INVERTED TYPE, GAIN 72.5 dB AT 1

TEST SET-UP BLOCK DIAGRAM (FIGURE 3)

